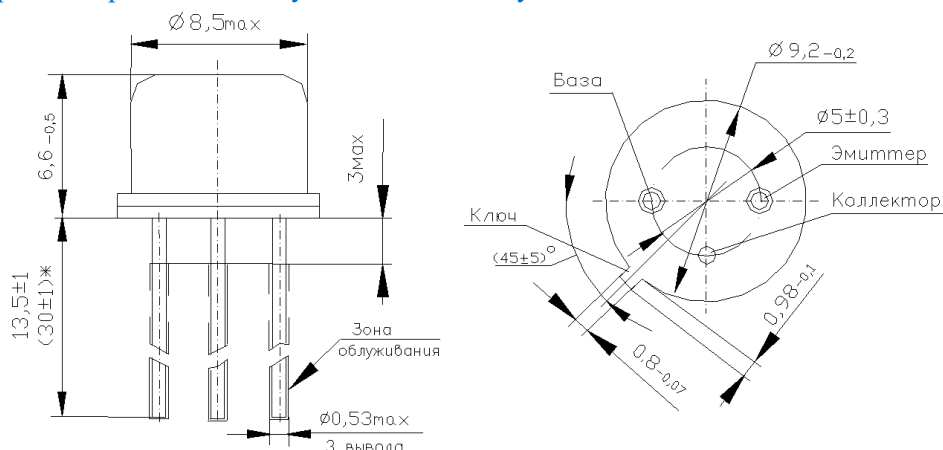




Транзисторы 2Т603И/ИУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п импульсные высокочастотные транзисторы 2Т603И/ИУ в металlostеклянном корпусе КТ-2, предназначены для работы в схемах аппаратуры специального назначения.

Транзисторы соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.400 ТУ.



Масса транзистора не более 1,75 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке ($T=25^{\circ}\text{C}$)

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=30\text{В}$), мкА	$I_{КБ0}$	-	3
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=4\text{В}$), мкА	$I_{ЭБ0}$	-	3
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, ($U_{КЭ}=10\text{В}$, $I_{К}=30\text{мА}$, $f=100\text{МГц}$)	$ h_{21Э} $	2	-
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}=10\text{В}$, $f=5\text{МГц}$), пФ	$C_{К}$	-	15
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}=0\text{В}$, $f=5\text{МГц}$), пФ	$C_{Э}$	-	40
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КЭ}=10\text{В}$, $I_{К}=30\text{мА}$, $f=5\text{МГц}$), нс	$\tau_{к}$	-	400
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}=2\text{В}$, $I_{Э}=350\text{мА}$, $f=50\text{Гц}$)	$h_{21Э}$	20	210
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{К}=350\text{мА}$, $I_{Б}=50\text{мА}$), В	$U_{КЭ_{\text{нас}}}$	-	1,2
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{К}=350\text{мА}$, $I_{Б}=50\text{мА}$), В	$U_{БЭ_{\text{нас}}}$	-	1,3
Время рассасывания ($I_{К}=150\text{мА}$, $I_{Б1}=-I_{Б2}=15\text{мА}$, $\tau_{п}\leq 30\text{мкс}$, $Q\geq 50$), нс	$t_{\text{рас}}$	-	70

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ_{\text{макс}}}$	30
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (при $R_{бэ}\leq 1\text{кОм}$), В	$U_{КЭ_{\text{макс}}}$	30
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер (при $R_{бэ}\leq 1\text{кОм}$, $\tau_{и}\leq 10\text{мкс}$, $Q\geq 10$), В	$U_{КЭ_{\text{и макс}}}$	45
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ_{\text{макс}}}$	4
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К_{\text{макс}}}$	300
Максимально допустимый импульсный ток коллектора ($\tau_{и}\leq 10\text{мкс}$, $Q\geq 10$), мА	$I_{К_{\text{и макс}}}$	600
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{К_{\text{макс}}}$	0,5
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{пер. макс}}$	150
Тепловое сопротивление, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{тп-окр.ср.}}$	200
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{окр.ср}}$	От минус 60 до 125

Изготовитель:

ОАО «НПП «ЗАВОД ИСКРА»
432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 75

тел.: (8422) 46-81-90, факс: (8422) 46-37-46, 46-37-47
e-mail: iskra@iptk.ru; Web сайт: www.zavod-iskra.ru